Провер. Артемьев Б.В 9строистоо бизуальной индикации 1 2 температуры в помещении МГТУ им. Н.Э. Баумана		По.		Наименование	Кол.	Примечание		
C7 X7R 50 - 0,001 мкф ±10% (Тайдань) 1		11: BQ	11	Кварцевый резонатор КХТ 12 МГц (Geyer, Германия)	1			
C7 X7R 50 - 0,001 мкф ±10% (Тайдань) 1	.нампс	.23.11						
С7 X7R 50 - 0,001 мкф ±10% (Тайдань) С8 X7R 50 - 4,7 мкф ±10% (Тайдань) С9 X7R 50 - 10 мкф ±10% (Тайдань) С10-С11 X7R 50 - 16 пф ±10% (Тайдань) С14-С74 X7R 50 - 0,1 мкф ±10% (Тайдань) С14-С74 X7R 50 - 0,1 мкф ±10% (Тайдань) ОА1 LM35DZ (ТІ, США) ОА2 LM3671MF (STMicroelectronics, Щвейцария) ОО1 STM32F103RDT6 (STMicroelectronics, Щвейцария) ОО2 WS2812B (Китай) Р1 Предохранитель MF-MSMF110 (Воигля, США) НЬ 1 Зеленый сфетодиод КРТ-3216СССК (Кіпдрігідіт, Тайдань) НЬ 1 Зеленый сфетодиод КРТ-3216СССК (Кіпдрігідіт, Тайдань) Катушка индуктивности СДЯН103RNР 22 мкГн (Китай) Р2 Катушка индуктивности СДЯН103RNР 22 мкГн (Китай) R1 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайдань) R2, R4 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайдань) R5 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайдань) R5 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайдань) R5 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайдань) R5 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайдань) 1 ИУ 4.11.04.03.23.11.31.11.001 ПЗ З	рв. п	04.03		<u>Конденсаторы</u>				
C2		7.11.7	1	X7R 50 - 0,01 мкФ ±10% (Тайвань)	1			
E8 X7R 50 - 4,7 мкф ±10% (Тайдань) 1 C9 X7R 50 - 10 мкф ±10% (Тайдань) 1 C10-C11 X7R 50 - 16 пф ±10% (Тайдань) 2 C14-C74 X7R 50 - 0,1 мкф ±10% (Тайдань) ???? Микросхемы DA1 LM35DZ (TI, CША) 1 DA2 LM367MF (STMicroelectronics, Швейчария) 1 DD1 STM32F103RD16 (STMicroelectronics, Швейчария) 1 DD2 WS2812B (Китай) ???? F1 Предохранитель MF-MSMF110 (Воигля, США) 1 HL1 Зеленый светодиод КРТ-3216CGCK (Кіпдрігідій, Тайдань) 1 L1 Катушка индуктивности СDRH103RNP 22 мк/н (Китай) 1 Резисторы R1 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайдань) 1 R2, R4 RC 0806 - 0.25 - 5 кОм ±1% (Тайдань) 2 R3, R7, R8 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайдань) 3 R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайдань) 1 Изм Лист мм докт мм докум Подпись Дата ИУ 4.11.04.03.23.11.31.11.001 ПЭ 3		₹ [2 -	<i>[6</i>	X7R 50 – 0,1 мкФ ±10% (Тайвань)	2			
C9 X7R 50 - 10 мкФ ±10% (Тайвань) 1	\mathbb{H}		7	X7R 50 – 0,001 мкФ ±10% (Тайвань)	1			
№ C10-C11 X7R 50 - 16 пФ ±10% (Тайвань) 2 С14-C74 X7R 50 - 0,1 мкФ ±10% (Тайвань) ???? В В В В В В В В В В В В В В В В В В В		[8	3	X7R 50 - 4,7 мκΦ ±10% (Ταῦβαнь)	1			
Микросхемы DA1 LM35DZ (TI, CШA) 1 DA2 LM367MF (STMicroelectronics, Щвейцария) 1 DD1 STM32F103RDT6 (STMicroelectronics, Щвейцария) 1 DD2 WS2812B (Китай) ??? F1 Предохранитель MF-MSMF110 (Bourns, США) 1 HL1 Зеленый светодиод КРТ-3216CGCK (Кіпдьгідht, Тайвань) 1 L1 Катушка индуктивности CDRH103RNP 22 мкГн (Китай) 1 Резисторы 1 R1 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайвань) 1 R2, R4 RC 0806 - 0.25 - 5 кОм ±1% (Тайвань) 2 R3, R7, R8 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) 3 R5 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) 1 КВ R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 КВ R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 КВ ИЗ Изм. Лист Nº докум Подпись Дата		[5	9	X7R 50 - 10 мκΦ ±10% (Ταῦβαнь)	1			
Микросхемы DA1 LM35DZ (TI, CШA) 1 DA2 LM367MF (STMicroelectronics, Щвейцария) 1 DD1 STM32F103RDT6 (STMicroelectronics, Щвейцария) 1 DD2 WS2812B (Китай) ??? F1 Предохранитель MF-MSMF110 (Bourns, США) 1 HL1 Зеленый светодиод КРТ-3216CGCK (Кіпдьгідht, Тайвань) 1 L1 Катушка индуктивности CDRH103RNP 22 мкГн (Китай) 1 Резисторы 1 R1 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайвань) 1 R2, R4 RC 0806 - 0.25 - 5 кОм ±1% (Тайвань) 2 R3, R7, R8 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) 3 R5 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) 1 КВ R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 КВ R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 КВ ИЗ Изм. Лист Nº докум Подпись Дата	9. No	£10-	[11	X7R 50 – 16 пФ ±10% (Тайвань)	2			
DA1 LM35DZ (TI, CША) 1 DA2 LM3671MF (STMicroelectronics, Щвейцария) 1 DD1 STM32F103RDT6 (STMicroelectronics, Щвейцария) 1 DD2 WS2812B (Китай) ??? F1 Предохранитель MF-MSMF110 (Bourns, США) 1 HL1 Зеленый светодиод КРТ-3216СБСК (Кіпдьгідht, Тайвань) 1 L1 Катушка индуктивности СПКН103RNР 22 мкГн (Китай) 1 Резисторы R1 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайвань) 1 R2, R4 RC 0806 - 0.25 - 5 кОм ±1% (Тайвань) 2 R3, R7, R8 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) 3 R5 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) 1 R6 R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 R9 Лист N° докум Подпись Дата ИУ 4.11.04.03.23.11.31.11.001 ПЭ 3	Спра	C14-6	<i>[74</i>	X7R 50 – 0,1 мкФ ±10% (Тайвань)	777			
DA1 LM35DZ (TI, CША) 1 DA2 LM3671MF (STMicroelectronics, Щвейцария) 1 DD1 STM32F103RDT6 (STMicroelectronics, Щвейцария) 1 DD2 WS2812B (Китай) ??? F1 Предохранитель MF-MSMF110 (Bourns, США) 1 HL1 Зеленый светодиод КРТ-3216СБСК (Кіпдьгідht, Тайвань) 1 L1 Катушка индуктивности СПКН103RNР 22 мкГн (Китай) 1 Резисторы R1 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайвань) 1 R2, R4 RC 0806 - 0.25 - 5 кОм ±1% (Тайвань) 2 R3, R7, R8 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) 3 R5 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) 1 R6 R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 R9 Лист N° докум Подпись Дата ИУ 4.11.04.03.23.11.31.11.001 ПЭ 3								
DA1 LM35DZ (TI, CША) 1 DA2 LM3671MF (STMicroelectronics, Щвейцария) 1 DD1 STM32F103RDT6 (STMicroelectronics, Щвейцария) 1 DD2 WS2812B (Китай) ??? F1 Предохранитель MF-MSMF110 (Bourns, США) 1 HL1 Зеленый светодиод КРТ-3216СБСК (Кіпдьгідht, Тайвань) 1 L1 Катушка индуктивности СПКН103RNР 22 мкГн (Китай) 1 Резисторы R1 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайвань) 1 R2, R4 RC 0806 - 0.25 - 5 кОм ±1% (Тайвань) 2 R3, R7, R8 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) 3 R5 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) 1 R6 R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 R9 Лист N° докум Подпись Дата ИУ 4.11.04.03.23.11.31.11.001 ПЭ 3								
DA2 LM3671MF (STMicroelectronics, Щвейцария) DD1 STM32F103RDT6 (STMicroelectronics, Щвейцария) DD2 WS2812B (Китай) F1 Предохранитель MF-MSMF110 (Воигля, США) HL1 Зеленый светодиод КРТ-3216СGСК (Кіпдьгідht, Тайвань) L1 Катушка индуктивности СDRH103RNP 22 мкГн (Китай) R1 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайвань) R2, R4 RC 0806 - 0.25 - 5 кОм ±1% (Тайвань) R3, R7, R8 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайвань) R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 MY 4.11.04.03.23.11.31.11.001 ПЭ З				<u>Микросхемы</u>				
DD1 STM32F103RDT6 (STMicroelectronics, Щвейцария) DD2 WS2812B (Китай) F1 Предохранитель MF-MSMF110 (Bourns, США) 1 HL1 Зеленый светодиод КРТ-3216СGСК (Кіпдьгідht, Тайвань) L1 Катушка индуктивности СDRH103RNP 22 мкГн (Китай) R1 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайвань) R2, R4 RC 0806 - 0.25 - 5 кОм ±1% (Тайвань) R3, R7, R8 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 WY 4.11.04.03.23.11.31.11.001 ПЭ 3		DA	1	LM35DZ (TI, США)	1			
ВОЗ WS2812B (Китай) F1 Предохранитель MF-MSMF110 (Bourns, США) HL1 Зеленый светодиод КРТ-3216СБСК (Кіпдьгідht, Тайвань) L1 Катушка индуктивности СDRH103RNP 22 мкГн (Китай) R1 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайвань) R2, R4 RC 0806 - 0.25 - 5 кОм ±1% (Тайвань) R3, R7, R8 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 WY 4.11.04.03.23.11.31.11.001 ПЭ 3		DA	2	LM3671MF (STMicroelectronics, Щвейцария)	1			
F1 Предохранитель MF-MSMF110 (Bourns, США) HL1 Зеленый светодиод КРТ-3216СGСК (Kingbright, Тайвань) L1 Катушка индуктивности СDRH103RNP 22 мкГн (Китай) R1 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайвань) R2, R4 RC 0806 - 0.25 - 5 кОм ±1% (Тайвань) R3, R7, R8 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) R5 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 Мэм Лист № докум Подпись Дата ИУ 4.11.04.03.23.11.31.11.001 ПЭ 3	_	DD	71	STM32F103RDT6 (STMicroelectronics, Щвейцария)	1			
НL1 Зеленый светодиод КРТ-3216СGCK (Кіпдьгідht, Тайвань) 1 Уда во применный светодиод КРТ-3216СGCK (Кіпдьгідht, Тайвань) 1 Резисторы R1 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайвань) 1 R2, R4 RC 0806 - 0.25 - 5 кОм ±1% (Тайвань) 2 R3, R7, R8 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) 3 R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 ИУ 4. 11.04.03.23.11.31.11.001 ПЗ 3		<i>DD2</i>		WS2812B (Kumaū)	777			
НЬ 1 Зеленый светодиод КРТ-3216СGCК (Кіпдьгідht, Тайвань) 1 L1 Катушка индуктивности СDRH103RNP 22 мкГн (Китай) 1 Резисторы R1 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайвань) 1 R2, R4 RC 0806 - 0.25 - 5 кОм ±1% (Тайвань) 2 R3, R7, R8 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) 3 R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 Изм. Лист Nº докум Подпись Дата ИУ 4.11.04.03.23.11.31.11.001 ПЗ 3	ата							
НL1 Зеленый светодиод КРТ-3216СGCK (Кіпдьгідht, Тайвань) 1 Уда во применный светодиод КРТ-3216СGCK (Кіпдьгідht, Тайвань) 1 Резисторы R1 RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайвань) 1 R2, R4 RC 0806 - 0.25 - 5 кОм ±1% (Тайвань) 2 R3, R7, R8 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) 3 R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 ИУ 4. 11.04.03.23.11.31.11.001 ПЗ 3	. u d	F	1	Предохранитель MF-MSMF110 (Bourns, США)	1			
L1 Катушка индуктивности СDRH103RNP 22 мкГн (Китай) 1	Под							
Резисторы R1	H	HL	1	Зеленый светодиод КРТ-3216СGCK (Kingbright, Тайвань)	1			
Резисторы R1	дубл							
Резисторы R1	1B. No	L	1	Катушка индуктивности CDRH103RNP 22 мкГн (Китай)	1			
R3, R7, R8 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 Изм. Лист № докум Подпись Дата 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>X</u>							
R3, R7, R8 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 Изм. Лист № докум Подпись Дата ИУ 4.11.04.03.23.11.31.11.001 ПЭ 3	. No			<u>Резисторы</u>				
R3, R7, R8 RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань) R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 Изм. Лист № докум Подпись Дата ИУ 4.11.04.03.23.11.31.11.001 ПЭ 3	M. UH	R1		RC 0806 - 0.25 - 100 кОм ±1% (Тайвань)	1			
R5 RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань) 1 N3M. Лист № докум Подпись Дата ПОДПИСЬ Дата	Вза	R2,	R4	RC 0806 - 0.25 - 5 кОм ±1% (Тайвань)	2			
Мэм. Лист № докум Подпись Дата ИУ 4.11.04.03.23.11.31.11.001 ПЭ 3		R3, R	7, R8	RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань)	3			
	ama	R5		RC 0806 - 0.25 - 130 Ом ±1% (Тайвань)	1			
	Подп. и б	Изм Лі	JCM .	№ доким Подпись Дата ИУ 4.11.04.03.23.11.31.11.001 ПЭ 3				
№ Провер. Про	\vdash	Разрад	5. K	утаев К.С. Четройство визиальной индикан	עע /			
	Ve no	Провер). [A	IIIIEMBEU D.D.	_			
Н.контр. Перечень элементов Кафедра ИУ 4 Утв. Группа ИУ 4-31 М	7нв. 1		р.			Кафедра ИУ 4		

	001	Поз . обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
Перв. примен.	ИУ 4.11.04.03.23.11.31.11.001	R6	RC 0806 - 0.25 - 470 Ом ±1% (Тайвань)	1		
	23.11	R9-R10	RC 0806 - 0.25 - 22 Ом ±1% (Тайвань)	2		
	94.03	R11-R12	RC 0806 - 0.25 - 10 кОм ±1% (Тайвань)	2		
	4.11.					
	ИЯ		<u>Переключатели</u>			
		SA1	SSSS820101 (KLS Electronic, Kumaū)	1		
Справ. №		SB1	SDTM-630-N (KLS Electronic, Kumaū)	1		
		VT1	Транзистор BC182LB (Fairchild, США)	1		
			<u>Разъемы</u>			
		XP1	PBS-5 (Connfly, Kumaū)	1		
		XP2	PBS-3 (Connfly, Kumaū)	1		
		XS1	MicroUSB Type-B 47346-0001 (Molex, Kumaū)	1		
		XS2	PLS-6 (Connfly, Kumaū)	2		
	1					
ата						
Подп. и дат						
Н						
Инв. № дубл.						
1HB. N						
1						
.B. Nº						
Взам. инв. №						
Взс						
дата						
Подп. и дата						
№ подл.						
			ИУ 4.11.04.03.23.11.31.11.001 ПЭ 3			
Инв.	Подпись Дата VI 3 4.11.04.03.23.11.31.11.001 113.					